

## 产品概览

### FDMQ8205A: GreenBridge™ 2 系列高效桥式整流器

欲看完整文档，请参阅数据表。

FDMQ8205A 是用于桥式应用的 GreenBridge™2 系列四 MOSFET，因此输入对器件所连接电源的极性不敏感。很多知名桥式整流电路均可使用传统二极管进行配置。传统二极管桥的功率损耗相对较高，在很多应用中都不希望发生这种情况。尤其对于要求高效桥接的以太网电源 (PoE) 供电设备 (PD) 应用来说更是如此，因为此应用要使用 IEEE802.3at 类别电源设备 (PSE) 提供的有限功率运行。FDMQ8205 配备了低  $r_{DS(on)}$  的双 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET，因此与传统二极管桥相比，可以降低由于电压降造成的功率损耗。FDMQ8205A 使得应用能够最大程度利用可用功率和电压，消除 PoE PD 应用中的热设计问题。FDMQ8205 GreenBridge™2 不会降低检测和分类要求，因此可兼容 IEEE802.3at PoE 标准。

### 特性

- 低功耗 GreenBridge™ 替代为二极管桥
- MOSFET 自驱动电路
- 低  $r_{DS(on)}$  100 V 额定电压 MOSFET
- 使有效功率和电压最大化
- 解决热设计问题
- 符合 IEEE802.3at 标准 - 满足检测和分类需求 - 工作在 2 和 4 对结构下 - 小反馈电压
- 紧凑的 MLP 4.5x5 包装

### 应用

- This product is general usage and suitable for many different applications.

### 终端产品

- IP Phones
- Network Cameras
- Wireless Access Points
- Thin Clients
- Microcell

### 器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DSS}^{(BR)}$ Min (V)	$V_{GS}^{Max}$ (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	$I_D^{Max}$ (A)	$P_D^{Max}$ (W)	$R_{DS(on)}^{n} Max @ V_{GS} = 2.5 V (m\Omega)$	$R_{DS(on)}^{n} Max @ V_{GS} = 4.5 V (m\Omega)$	$R_{DS(on)}^{n} Max @ V_{GS} = 10 V (m\Omega)$	$Q_g^{Typ} @ V_{GS} = 4.5 V (nC)$	$Q_g^{Typ} @ V_{GS} = 10 V (nC)$	$C_{iss}^{Typ} (pF)$	Package Type
FDMQ8205A	1.1544	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Complementary	Quad	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	WDF N-12

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 [www.onsemi.cn](http://www.onsemi.cn)。

创建于：9/30/2020